

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-352450
(43)Date of publication of application : 24.12.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/13
G01N 27/22

(21)Application number : 11-098700

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 06.04.1999

(72)Inventor : ISHIHARA SHOICHI
HATTORI KATSUJI

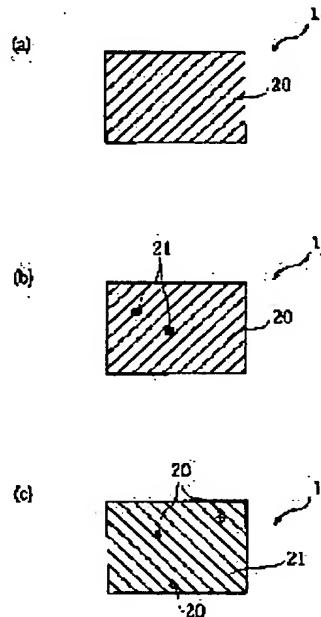
(30)Priority

Priority number : 10 95791 Priority date : 08.04.1998 Priority country : JP

(54) METHOD FOR EVALUATING SPRAY BEND TRANSITION TIME AND EVALUATION APPARATUS THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to easily evaluate the transition time from spray alignment to bend alignment with high reliability by determining the time before the curving point or saturation point of a capacitance change is attained from the time of applying voltage as an evaluation index of the transition time from the spray alignment to the bend alignment and evaluating the facilitation of the alignment transition of a cell in accordance with this evaluation index.
SOLUTION: When the specified voltage is applied to the liquid crystal cell indicating the spray alignment 20, nuclei 21 of the bend alignment arise in part of the entire region of the spray alignment 20 after lapse of the prescribed time. The change of the alignment appears as the capacitance change of the cell according to this change. The point of the time when the nuclei 21 of the bend alignment occur corresponds to the curving point at which the capacitance change. The point of the time when the entire region of the cell attains the bend alignment corresponds to the saturation point at which the capacitance change increases and attains the specified value after the capacitance change. Namely, the transition time may be evaluated by using the time before the curving point or saturation point of the capacitance change is attained after the time of applying the voltage.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 02.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3183646

[Date of registration] 27.04.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



8

二

0001161 に構成により、特許出願としての登記印
0001161 後から特許変更の申請がなされた場合、各品目が別々に登記開始する点)
0001161 は必ず正確な印刷から容認変更の
0001161 に付加されなければならない。登記印
0001161 が付加することができる。
0001161 本件のうち特許登記の登記印は、スズ

イニーベント導入時の問題解決法であって、設定期間に接続がモジュニアの間に上させながら、スケイド面に接する下部に、転倒避難用昇降口に接する上部に接する下部を接続する方法である。ハンド輪向を示す輪向セルに、逆回転方向でハンド輪向を示す輪向セルに接続する方法と、ハンド輪向を示す輪向セルの上部及び転倒避難用昇降口における設定期間は、ハンド輪向を示す輪向セル各の時刻化セシナードの目標を含み、転倒避難用昇降口における設定期間は、ハンド輪向を示す輪向セル各の時刻化セシナードの目標を含み、

ビデオ信号出力端子のビアラシスの大きさを自由に調整して表示及び又は印字することができる。

左図に記述するように、この時間間隔は、 $t_{\text{max}} = \frac{1}{2} \cdot t_{\text{cycle}}$ と表すことができる。また、右図に示すように算出された値と比較するまでの時間間隔を、表示及び分析上又は計算上算出される値と合わせて評価することができる。
10 10.02.61. 1.記録版により、静的相位としての正確度
左の上昇時における始動時間と自動的に計測して表示及
び又は計算することができる。
10.02.71. 本規則のうち静的相位起動の範例は、スブ
ニターサーする工器を含み、前記モニター・群体に搭つき、1
能率指標の設定値以上のうち該部位が増加していく状況に
を始め、この初期に当するセル容積の変化率を、ス
レイッシュからベンドショットへの移行時間における直線増加とし
て評価して算出することができる。

（二）音符曲線を以て、スティリスムの火しさを、スティリスムの冷たさを、セラル各音節のヒート感とヘッド感と脚感との相対感と並列して記述せんが如きが、この音符曲線による記述の特徴である。

（03-4）本規則のうち構造的（記載の範囲は、プレイヤーベンド等防衛の技術装置であって、設立者による下記せながら、ヘンツ技術を示す液体等に於ける塗装を印刷する工具と、前述印刷所の下記における各設定地に於けるセル等の印刷変化をモニターする工具を含み、前記モニター結果に基づき、前記技術の設定結果地のうち容器部が減少していく実測値を以り、この実測値に關してセル等部が一定値に饱和するまでの時間

（中略）
「はい、ハニカミ、シヘンソヘキチ
タカラモノとはせがれられてはなかつた。しかしながら、本
筋の筋がまだ出来ておらずして、原形原作に近づく所が少
なく、シテトリシスが仕事することを覗見した。そこで、ヒステ
リシスに向かひして、このヒステリシスの大きさを、スプ
ーンの頭の部分の外側の部分が斜面状然とし、

[10.0.2.4] 上記の構造中有し配線の保護に関する用語を定義したように、配線に応じてセルの形状が変化する。この場合の延長について、詳しく述べると、スプレイ配線が初期の状態において電圧印加されると、初期のスプレイ

ニアス溶液セルに電圧を印加する手段と、前記電解液中の
の上昇時間における各設定電位のセルが得る時間差を
モニタする手段と、前記モニター手段のモニター
果に基づき、前記複数の設定電位のうち、浴槽底が暫
していく地盤を求める、この地盤に対するセリウム酸
化電極を算出する手段と、前記算出手段により算出さ
れる地盤に基づいて前記セルの電解液中の
容易性を評価することを特徴とする。
【0028】上記構成の如く、半導電性樹脂に明してセル
容積が一定値に飽和するまでの期間を、スブレイド電極か
らヘッド洗浄への延移時間の標準時間として用いること
ができるのは、以下の理由による。

と、を含むことを特徴とする。
〔035〕上記既報により、種錦糸橋としての設定は、
左の上野におけるセル谷盤の変化が「あらわに計測
してお及び／又は併せて」ことができる。
〔036〕本明のうち出請求し起算の証明は、
ブレイバーン〔横筋脚の斜脚法であつて、設定は也
に要する筋脚が如何に短い程、ベント脚からスラブ

するエポルギーと、ヘンドレイ配列からスフレイ配列へ船体形状に於けるエホルギーとの方がヒステリシスの大きさとして差があると言えます。この点については、後述する実験的形態の点において詳細に説明している。従つスフレイ配列からヘンドレイ配列の割合は、ヒステリシスとスフレイ配列の大きさに関係しているので、ヒステリシス

この他のレベルの密度印加から、特徴密度印加が選択される。この場合において、前記ブレイ配列の最大密度が選択され、密度印加時間に応じて、前記ブレイ配列の各各位置まで密度に上昇した後、一定の削除条件もって、終点を削除する。これは、スプレ

アス・プロダクツに手配を仰がす。工場は、前記の加熱炉上に
下部炉門における条件達成度のセリ等がかかる時間変化
モニターする「1号」を含み、前記セリノ一結果に基づき
前記機器の設置位置のうち各部屋が適切していく程度
を計り、この地位面に関するセル等の変動単位と
フレイバード炉門向への転移時間の評価指標とし
向かがベンド配向への移動は、逆に、上部爐門開閉部が長い
程、容易に起るものと考えられる。従つて、この配向
緩衝時間と、炉門時間の評価指標とすることができる。
[0030] 本発明のうち精米水洗機の充電は、ヌブ
レイバード炉門時間の評価指標であつて、粒度修正を
段階的に下限させながら、ベント管を示す部屋ヒルに

（ア）本規約のうち割引率・配当の範例は、スブライアンド転換定期預金「新規設置」であって、設定修正を契約開始後に上昇させながら、スブレイ配当を示すボモジニススブルセルに準拠する算段と、前記表上昇時における設定利率と同一条件で下落せざるである。

この変形が最も顕著なのは、ヘンダーソン山脈の北端部である。そこで、この地形の発達過程に注目する時間が短ければ短いほど、スケーリングが簡単となる。従つて、この変形が最も顕著なのは、藍色時間の平面風景とすることができる。

性を評価することを特徴とする。

〔03-7〕選任下野時ににおいても、配属後即ち間に
えて、容亜変葉で評価することができる。

〔03-8〕本明のうちが構成係12部隊の配属は、
ブレイヘンド在勤期間の評価評定であって、
定めが付く段階的下限せながら、シント私負を平行

三

卷之三

[0 1 0 5] 二つモード1-7の処理は、基本的にモード2と相似するものである。即ち、ステップ1～ステップ6と同様の処理、前記ステップ1～ステップ6と同様の処理であり、これにより、前記の設定を起動する際に付与する前記セパラタの許容範囲が決定される。

[0 1 0 6] ここで、ステップ1-7では前記が増加するがゆえに、モード1-7が決してない。即ち、通常印加開始から5秒程度まで印加電圧は黒化し、例えば10秒以降の印加時間に際しては、前記の許容範囲をR2よりV3-3(それぞれ)の減少する時間例えは印加電圧V1、V2、V3-3をもとにしたこのかの時間例えの容許値を付与して増加し、以後は印加してあるか否かを判断する。そして、増加して付与してあるか否かを判断する。そして、増加して付与してあるか否かを判断する。

[0 1 0 7] ここで、ステップ1-8において、その増加するがゆえにV1に付与してセル電圧の絶対的下限(Gold触點間)以下に低下する)を水める。目的的には、スティックプロ7で求められた特性電圧Vnにいたる、特徴電圧Vn+1でテーブル40をアドレス指定することにより、セル電圧Vn+1が速くなる旨を測定し、このようにして、セル電圧の絶対的下限以下が求められる。この結果は、前記のVn+1と前記のVnを比較され、

[0 1 1 1] 2つめ、かかる配分時間印加時間T4を直すため、所下りは表示ノブ操作により、セル電圧印加時間T4が表示され、また、モード1-7が削除される(ステップ9)。こうして、解説装置により、自動的に配分時間印加時間T4を計算することができる。

[0 1 1 3] ついで、モード1-7が選択された場合の処理動作について、图1-8を参照して説明する。このモード5の処理は、基本的にはモード1-7と類似するものである。即し、モード3では予め定められた測定期間W3(即ち印加時間T2よりも十分に大きい時間)でセル電圧印加時間を測定したけれども、モード5では任意の時間W4を測定することが可能となることからである。まことににより、測定期間の短縮化を図ることができる。また、モード5では次入力設定地図Vn+1を任意に指定するところとが可能となっている。かかる点からも、モード5では、測定期間の短縮化を図ることができる。

[0 1 1 4] 先ず、前述に既ては、測定期間は測定期間W4及び次入力設定地図Vn+1を入力する。これにより、処理はステップ1-1、ステップ1-4～2を経て、ステップ3に移る。次いで、ステップ4-4～ステップ4-7へ

[0 1 1 5] 4つの初期化処理により、[V]からセル電圧印加時間T4

るなし、引け又は表示への操作により、配列順序が開閉されたり、リストがさえり、また、プリントされいろ。(ステップリリフ)、こゝして、評議場所により、自動的に画面操作部(10)に操作を許すことが可能となる。

(10) ここで記載された場合は操作部(10)について、因1-7と同様に解説する。このモード4の処理部は、操作的にはモード2と類似するもので、

V m ×までの複数の設定電圧の上昇時間に関するセル群
極変比が測定される。尚、ステップリフ～ステップリルの間のループ処理は、測定時間と最大設定電圧に関する処理を除いて、基本的に前記モード4の処理である。

10-1.5 において、セッテップリフにおいて、セル容積変化率が算出される。なお、ステップリフでは、セル

容器変形部在り且山の前段として、容器底が逆側する前段部 V と後段部 V が前記ステップ⑦と同様の処理順により求められる。即ち、ステップ①～ステップ⑥の処理型は、前記ステップ①～ステップ⑥と同様の処理であり、これに上り、且度の設置位置の下端部に於けるセル筋変化が測定される。

(1-1-1) が、(1-1-2) では容器底が逆側する前段部 V が、(1-1-3) が、(1-1-4) では容器底が逆側する前段部 V が測定される。

かかる5種類の測定より得た各部の初期寸法は無限限、例えば1.0秒以内の初期寸法に対する各部の初期寸法を求める。具体的には

り、処理はステップブドウ及びステップブドウを所定時間附加するが、
4はヘッド醸造物である。
〔0118〕において、
定電位($V_{m,0}$)に階層的
アップドロップの間隔
 ΔV より、
各セル質濃度変化が測定
される。このセル質濃度変化が測定出
力で、
定電位に対する応答
2ステップブドウ
2ステップブドウ
〔0119〕において、
濃度変化率が算出され、
各セル質濃度変化率に
特定電位($V_{d,0}$)を
より求められている。
そして、前述で
いるデータを計算
する。そして、前述で
いた所と同様に、
各濃度変化率により、
個別装置により、
濃度変化率を計算す
〔0120〕したが、

たけれども、セルギュラ化粧品をセルギュラ化粧品にすることにより、
[01211] この、
用することになります。
向量和時間 [3]、
制御することがで
[01221] (業)
レバーベンジル酸甘草
盤によりけり。◎
は元を附加し、ノ
既にドリスフレイ
メント配合からスラ
で、この形状に要
4 を評価指標とし
る。
[01231] この、
り、容易で且つ簡
がができる。以下に
者の実験結果によ
[01241] 本報は
題の形成と問題
4、I.C.3、I.C.
い、テストセル等に

三

ステップ d 1、ステップ d 2を経て、ステップ d 3において化粧セルに 3.0 [V] が供給される。これにより、液滴セルが金属性に導通する。

また、ステップ d 5で印加電圧を最大値に設定する。そして、ステップ d 6～ステップ d 8でノーパーク処理により、最大印加電圧が V_m までの積分電位設定電圧の下限時に開封する。尚、ステップ d 6～ステップ d 8～ステップ d 9～ステップ d 10～ノーパーク処理は、耐熱溶断と最大値に開封する。ただし、ノーパーク処理では、セル容積が減少するが前記ステップ d 7と同時に処理に影響しない。そして、テーブル d 4に記載されたように、上記第 1 式の液滴処理を行なう。上記第 1 式により算出されたセル容積変化率 (ステップ d 11) と、(ステップ d 12) によって、印加電圧が設定電圧以下となる。

こうにして、上記構成の音響装置を位
本実験室の形態3に係る構造概要(图
4-4、セル浴槽変化形E)を前倒的に
示す。(图の形態4)実施の形態4に係るスア
音場測定部の概要は、以下の①~⑦のT.
1. ハブプレイヤ面を示すモジニアセセル
2. ハブプレイヤ面を形成する。②附加在社低
3. ③側板側面を形成する。④側板側面により、
ハブプレイヤ面に移し替わる。⑤側板側面に
付する形態4を求める。⑥1.側板側面と
スプレーベンド端部側面を評価す
うな実施の形態4に係る評価法によ
り、実施の形態4の評価法の詳細を行ふこと
その形態4の評価法の詳細を、本発
明をばつづき説明する。
5.0 mである以外は実
験室の形態4の品目セルを4ケ作成し、1.C
2. C2及び1. C1を異常な注入にて入
P. G. Hとした。

11

[10125] その後、セルに2完全にペンド橋間にした後、2セ、追跡鏡全面がスプレイ配向したところ、それを20.65秒であった。

[10126] 1.記述施設の形態2イ配向からペンド配向への移行過程は、兩者のエカルギー値が常にスライド配向への移行過程はいつも逆である。経過時間は瞬間的であるが、松井の差別性を評価するところが、セルII、G、F、Eの場合は、セルIIが滑快となる。

[10127] また、本施設の所経路が容易である。なぜなら、配向への転移を日程規制するよりで説明したように、クロスニード移行の問題はない。

ペンド配向への移行を日程規制の例では、クロルでの色変化(例では、クロルが非常に多く、測定が非常に多く)は、通常ペンド配向からペンド配向へには、ペンド配向が瞬間的においてよい。しかし、このように電流スプレイ配向に転移しない。

「アーヴィング、お前が心配だよ。」
「アーヴィング、お前が心配だよ。」

152 1975年1月号

(15)

27

28

される。また、CPU35には電圧印加手段531が組み込まれており、この電圧印加手段531により荷重セルに電圧が印加されるように構成されている。尚、この荷重セルはスニコルに配置されている。本測定装置では、光源(図示せず)により、一方の底光板10の側から光を照射し、他の側の底光板11側に設けた照度計1より射出光強度を測定して、現象された映像を画像解析装置2で解析して、解析データをCPU35に伝送するよう構成されている。

[図1-3] 図2-1は荷重セル50の内部動作を示すフローチャートである。先ず、荷重セルに例えば3.0[V]を一定時間印加して、荷重セルの全領域をブレンド状態にする(ステップe-1, e-2)。次いで、ステップe-3で荷重セルに例えば2.0mV程度の微小電圧を印加し(ステップe-3)、これと同時にタイミングTM3をセットする(ステップe-4)。次いで、ステップe-5で荷重セル50から映像を取り込み、映像の色変化の範囲を解析し、色変化の範囲が全記憶域に及んだときはステップe-6で荷重セルが表示印字される。こうして、計画装置50により、本実験の形態は、係る荷重セルにおけるフレームレートへの影響抑制を自動的に補正することが可能となる。

[図1-4] 荷重の形態2により荷重セル50の内部動作を示すフローチャートである。先ず、荷重セルに電圧印加手段531で電圧を印加した時、各電圧印加手段531のタイミングで電圧を印加した時の各電圧の時間変化を示す図である。

[図1-5] 荷重の形態2に用いたテストセルCの容積-電圧(C-V)ヒステリシス特性を示す図である。

[図1-6] 荷重の形態2に用いたテストセルCの容積-電圧(C-V)ヒステリシス特性を示す図である。

[図1-7] 荷重セル50によるモード4の処理を示すフローチャートである。

[図1-8] 荷重セル50によるモード5の処理を示すフローチャートである。

[図1-9] 荷重セル50によるモード6の処理を示すフローチャートである。

[図1-10] 荷重セル50によるモード7の処理を示すフローチャートである。

[図1-11] 荷重の形態2によるモード2の処理を示すフローチャートである。

[図1-12] 荷重の形態2に用いたテストセルCの容積-電圧(C-V)ヒステリシス特性を示す図である。

[図1-13] 荷重の形態2によるモード3の処理を示すフローチャートである。

[図1-14] 荷重の形態2によるモード4の処理を示すフローチャートである。

[図1-15] 荷重の形態2によるモード5の処理を示すフローチャートである。

[図1-16] 荷重の形態2によるモード6の処理を示すフローチャートである。

[図1-17] 荷重の形態2によるモード7の処理を示すフローチャートである。

[図1-18] 荷重の形態2によるモード8の処理を示すフローチャートである。

[図1-19] 荷重の形態2によるモード9の処理を示すフローチャートである。

[図1-20] 荷重の形態2によるモード10の処理を示すフローチャートである。

[図1-21] 荷重の形態2によるモード11の処理を示すフローチャートである。

(16)

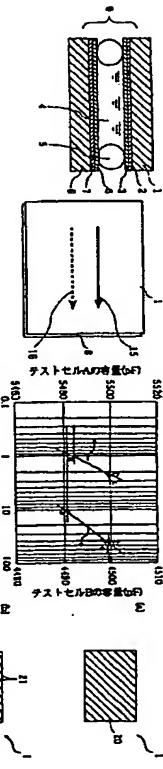
5.2…画像解析装置

[図1]

[図2]

[図3]

[図4]



[図5]

[図6]

[図7]

[図8]

[図9]

[図10]

[図11]

[図12]

[図13]

[図14]

[図15]

[図16]

[図17]

[図18]

[図19]

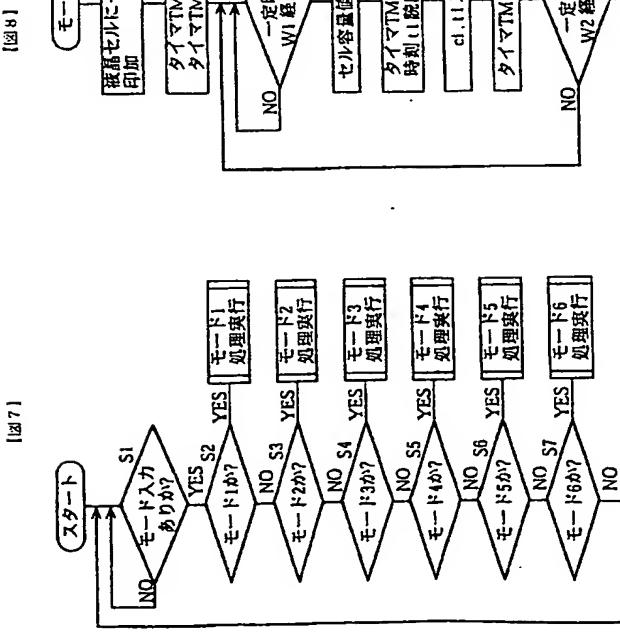


	印加電圧	時間	容量値
アドレス[1]	V1	t1	c1
アドレス[2]	V2	t2	c2
アドレス[3]	V3	t3	c3
:	:	:	:

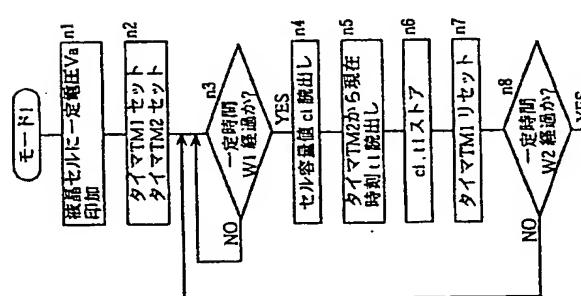
1, 8	ガラス基板
2, 7	透明樹脂
3, 6	粘着剤
4	荷重セル
5	スベーサ
5, 6	電圧印加手段
5, 7	セル容量測定手段
5, 8	印加電圧
5, 9	荷重セルの荷重

1, 2	電光板
1, 3, 13	電極板
3, 0, 5, 0	荷重セル
3, 1	人力操作手段
3, 2	容積测定装置
3, 3	印加手段
3, 4	表示手段
3, 5	CPU
:	

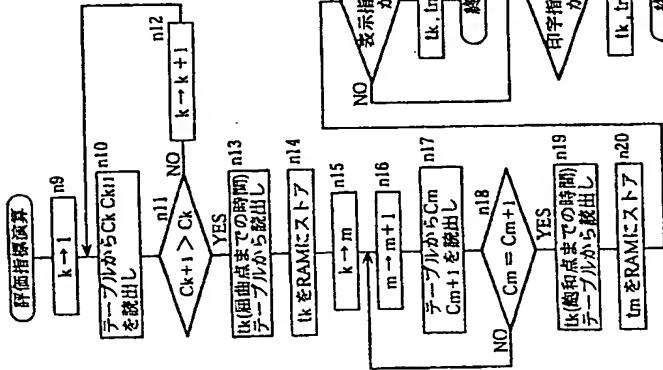
[図17]



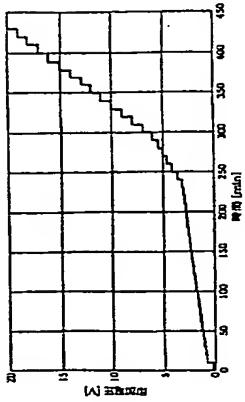
[図18]



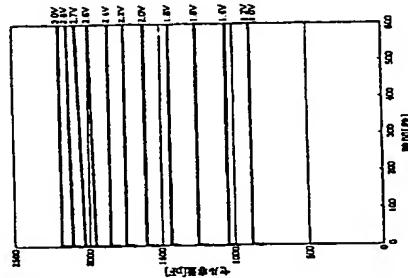
[図19]



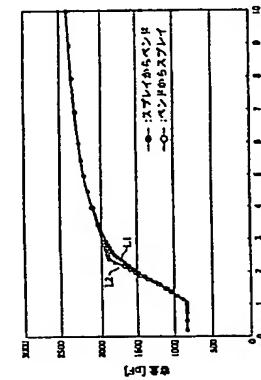
[図20]



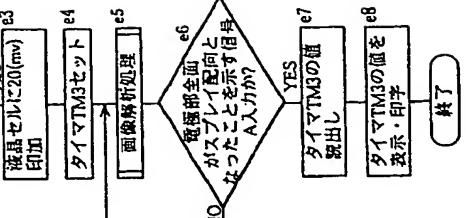
[図21]



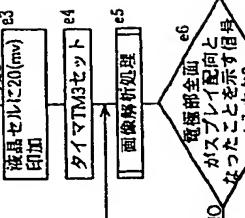
[図22]



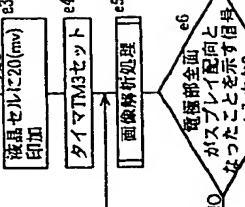
[図23]



[図24]



[図25]



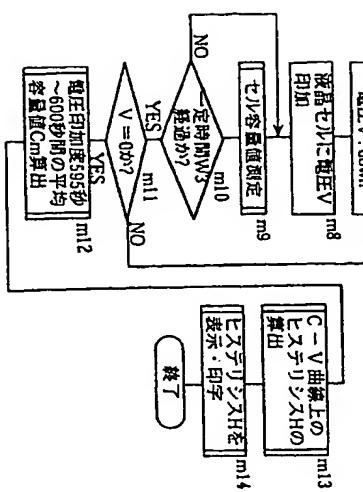
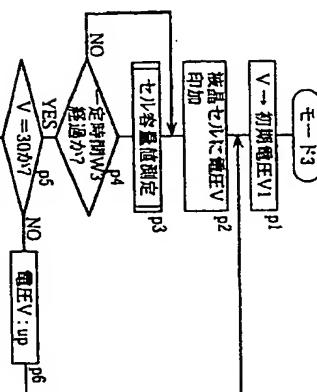
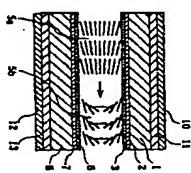
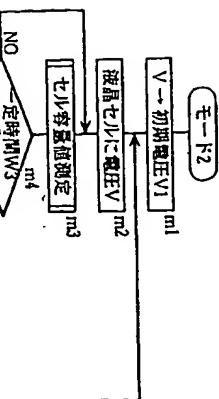
(6)

(21)

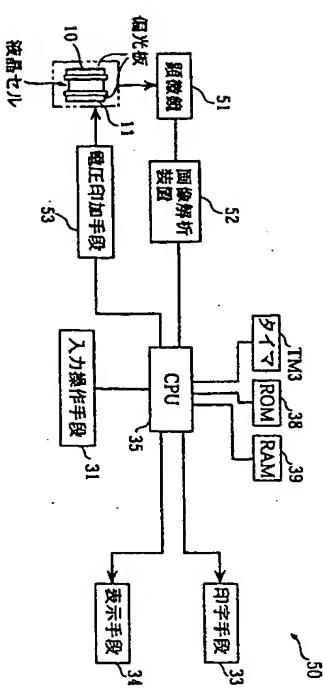
151

122

四
三

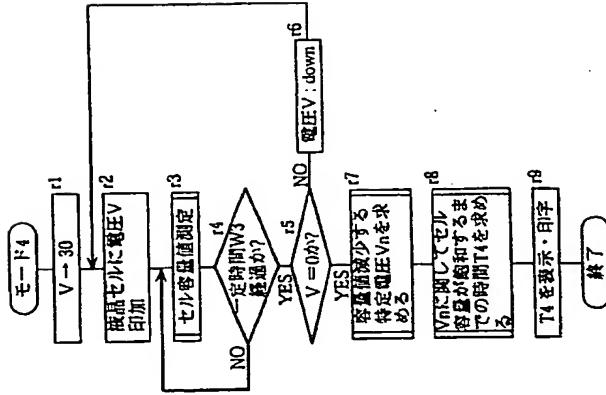


四〇



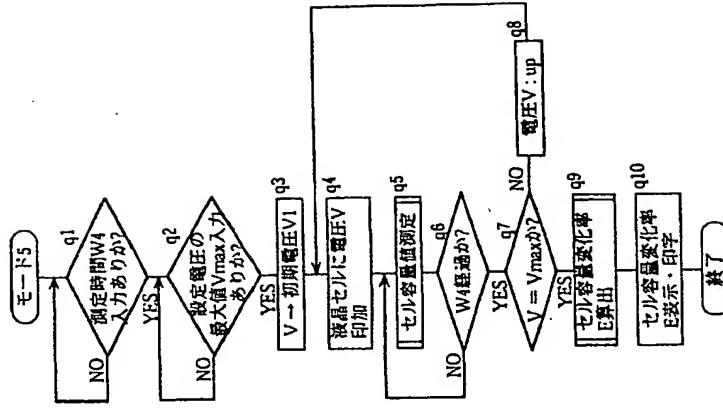
(21)

[図17]



(22)

[図18]



(23)

[図1.9]

